

PHOTOMASK BLANK

Patent Number: JP59090852
Publication date: 1984-05-25
Inventor(s): MATSUI SHIGEKAZU; others: 03
Applicant(s):: HOSAKA GLASS KK
Requested Patent: JP59090852
Application Number: JP19820199786 19821116
Priority Number(s):
IPC Classification: G03F1/02 ; H01L21/30
EC Classification:
Equivalents: JP1420094C, JP62027386B

Abstract

PURPOSE: To enable removal of remaining Cr without requiring overetching at the time of development by raising nitride degree of a CR layer near a substrate in a photomask blank prepared by forming the Cr layer contg. N on the transparent substrate.

CONSTITUTION: The photomask is obtained by laminating an N-contg. Cr layer 22 comparatively high in nitride degree and an N-contg. Cr layer 23 comparatively low in nitride degree on a transparent substrate 10 made of soda lime glass finely polished on the surface. Further, a Cr oxide layer 32 contg. N may be laminated on said Cr layer 23.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑪ 特許公報 (日2)

昭62-27386

⑤ Int. Cl.
G 03 F 1/00
H 01 L 21/30識別記号
GCA庁内整理番号
V-7204-2H
Z-7376-5F

⑫⑬公告 昭和62年(1987)6月15日

発明の数 1 (全5頁)

⑭発明の名称 フォトマスクブランク

⑮特願 昭57-199786

⑯公開 昭59-90852

⑰出願 昭57(1982)11月16日

⑱昭59(1984)5月25日

| | | | |
|------|---------|--------------------|-----------|
| ⑭発明者 | 松井 茂和 | 東京都新宿区西新宿1丁目13番12号 | 株式会社保谷硝子内 |
| ⑭発明者 | 加賀谷 健一 | 東京都新宿区西新宿1丁目13番12号 | 株式会社保谷硝子内 |
| ⑭発明者 | 牛田 正男 | 東京都新宿区西新宿1丁目13番12号 | 株式会社保谷硝子内 |
| ⑭発明者 | 丸山 光一 | 東京都新宿区西新宿1丁目13番12号 | 株式会社保谷硝子内 |
| ⑭出願人 | ホーヤ株式会社 | 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 | |
| ⑮審査官 | 石井 良和 | | |

1

2

⑯特許請求の範囲

1 透明基板上に窒素を含むクロム層を積層させ、または該クロム層に更に酸化クロム層を積層させてなるフォトマスクブランクにおいて、該クロム層のうち、窒化度が該透明基板に近い層に大きく、かつ遠い層に小さいことを特徴とするフォトマスクブランク。

発明の詳細な説明

この発明は半導体素子、IC、LSI等の半導体製造に使用されるフォトマスクブランクに関する。この種のフォトマスクブランクとしては、基本的に第1図aに示されるように透明基板1上に真空蒸着法、スパッタリング法またはイオンプレーティング法等によってクロム層2を積層させた、比較的表面反射率の高いものと、同図bに示されるように前記クロム層2上に更に酸化クロム層3を積層させて反射防止層付きのもの（低反射フォトマスクブランク）と、同図cに示すように透明基板1上に酸化インジウム、酸化スズなどの帯電防止用の透明導電膜1'を積層して、導電性をもつた透明基板1'を使用し、この透明基板1'上に前述したクロム層2更にこのクロム層2上に酸化クロム層3を積層した透明導電膜付きフォトマスクブランクがある。したがって、この発明においては、単に透明基板というときは、後述するようなソーダライムガラスなどの透明基板単体の他に、透明導電膜付きのものが含まれる。

このようなフォトマスクブランクを半導体製造に使用される際には、第1図aに示したクロム層2または同図bに示した酸化クロム層3上にそれぞれレジスト（本例ではポジレジスト）を塗布し、所望のパターンを適当な露光装置により露光させた後、レジストを現像して形成されたパターンのうちから、露光された部分のレジストと、その下のクロム層2、酸化クロム層3をエッチングしたうえで、前記現像によって溶解しなかつたレジストを剥離して、所定の半導体製造用フォトマスクを得るものである。

ここまでの中程、前記レジストの塗布後には、レジスト膜とフォトマスクブランク（より詳しくはクロム層2または酸化クロム層3）との接着性を高め、レジスト中の溶媒を蒸着させるためにプレベークと呼ばれる熱処理工程を必要とする。この熱処理工程中またはその後工程で第2図aに示すようにレジスト4上に異物5が乗った場合、その異物5下のレジスト4は、前述した露光によっても未露出部分となって、現像後のレジスト4が同図bに示すように残ることから、次のエッチング工程、レジスト剥離工程後において同図cに示すようにクロム残り20, 30が発生する。このようなクロム残り20, 30は直径約1 μm の大きさを有し、1 μm オーダーの高精度パターンが要求されるフォトマスクとしては致命的欠陥となる。このクロム残り20, 30の除

去手段としては、オーバーエッティングすることが考えられるが、その場合パターン寸法が極めて細くなり、微細寸法の制御に支障を来たすことになる。以下、このオーバーエッティングによる欠陥を5 従来のフォトマスクプランクを挙げて具体的に説明する。

表面を精密研磨した透明ガラス基板上に、圧力 1×10^{-3} (Torr) のArとN₂をそれぞれモル比85% : 15%にした混合ガス中で、プレーナマグネット10 ロン直流スパッタリングにより窒素を含むクロム層(650Å) (第1図bにて2に相当する。) を積層させる。次に、同一真空中で、ArとNOをそれぞれモル比80% : 20%にした混合ガス中で同様のスパッタリングにより前記クロム層上に、窒素を含むクロム酸化層(第1図bにて3に相当する。) を積層させ第1図bに示したような低反射プランクを製造した。この低反射プランクは、前述したようにレジスト塗布、露光現象及びレジスト剥離の各工程の後、硝酸第2セリウムアンモニウム165gと過塩素酸(70%) 42mlに純水を加えて1000mlにしたエッティング液(19~20°C) でウエットエッティングすることにより所定のパターンを形成した場合、エッティング時間が30(sec) でアンダーカット量が約0.28(μm) であった。ここで、アンダーカット量とは、第2図dに示すようにオーバーエッティングした場合においてレジスト41 下の幅寸法x₁と、窒素を含むクロム層21 及び窒素を含むクロム酸化層31の最大寸法x₂との差である。

そこで、エッティング時間を更に経過させてアンダーカット量及びクロム残り密度を測定した結果50 をそれぞれ第3図の特性曲線a及びbで示す。特性曲線aによれば、オーバーエッティングすることによりアンダーカット量を増加させ、また特性曲線bによれば、クロム残り密度を減少させることになる。

次に(エッティング時間)/(ジャストエッティング時間)に対するクロム残り密度の関係を第4図の特性曲線cで示す。ここでジャストエッティング時間とは縦方向(厚み方向)のエッティング速度が飽和するまでに要する時間である。同図の曲線cによれば、クロム残り密度を0.1(個/cm²)以下にするには、エッティング時間をジャストエッティング時間の2倍以上も要する。

したがつて、従来のフォトマスクプランクは、クロム残りの除去手段としてオーバーエッティングするしかなく、そのオーバーエッティングにより半導体製造で要求される微細寸法のパターン制御を困難にしていた。

この発明の目的は、過剰なオーバーエッティングをすることなく、クロム残り密度を減少させたフォトマスクプランクを提供することである。このような目的の達成手段としては、N₂ガスのモル比を多くして各層のエッティング速度を大きくすることが考えられるが、その場合アンダーカットレートが大きくなつて微細寸法の制御が困難になり、根本的な解決にはなり得ない。

そこで、本発明者は、特に透明基板上に積層した窒素を含むクロム層が従来ほぼ同一の窒化度で構成されていたのに対して、この窒素を含むクロム層のうち、透明ガラス基板に近い層と遠い層とに分け、エッティング速度を近い層にて比較的早くして、遠い層にて遅くすることにより、過剰なオーバーエッティングをすることなく、クロム残りを除去することを見出した。以下、この発明に係るフォトマスクプランクの実施例を挙げて詳細に説明する。

第5図a及びbは、従来品の第1図a及びbに25 それぞれ対応して示した、この発明の実施例による断面図である。第5図aは、比較的表面反射率の高いフォトマスクプランクの例で、表面を精密研磨したソーダライムガラスからなる透明基板10 上に、窒化度が比較的大きい窒素を含むクロム層22を、そのクロム層22上に窒化度が比較的小さい窒素を含むクロム層23をそれぞれ積層してなるフォトマスクプランクであり、第5図bは更に前例のフォトマスクプランクのクロム層2330 上に窒素を含む酸化クロム層32(膜層250Å)を積層してなる低反射フォトマスクプランクである。

そこで、この低反射フォトマスクプランクについてクロム層22とクロム層23の各窒化度を相対的に変えたものを表に示すように用意し、膜厚40 についてはクロム層22を150Å、クロム層23を500Åにし、このクロム層23上に前述した酸化クロム層32を積層し、光学濃度については、所望値3.0が得られるようにスパッタリング速度を調整し、その他は従来と同様なスパッタリング

(3)

5

法により各層を積層する。

| | クロム層22 モル比Ar:N ₂ | クロム層23 モル比Ar:N ₂ |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 実施例1 | 75:25 | 85:15 |
| 実施例2 | 60:40 | 85:15 |
| 実施例3 | 40:60 | 85:15 |
| 従来品 | 85:15 | 85:15 |

これらの実施例1、2、及び3によれば、先ずエッティング時間に対するアンダーカット量の特性曲線は第3図の曲線aに示したものといずれもほぼ同一であつて、しかも(エッティング時間)/(ジャストエッティング時間)に対するクロム残り密度の特性では、それぞれ第4図の特性曲線d、e、及びfで示される。すなわち、いずれの実施例も、クロム残り密度を0.1(個/cm²)以下にする場合には、ジャストエッティング時間に対するエッティング時間を1.4倍以上にすれば良いことになる。ここで、クロム層22、23の積層におけるArとN₂の混合ガス中の窒化度に対するエッティング速度の関係は第6図の曲線gで示されるよう、エッティング速度は窒化度が大きくなるに従つて増大する傾向にある。そして、クロム層22はクロム層23よりも窒化度を大きくするに従つて(曲線d→e→f)、クロム残り密度を小さくすると共に、(エッティング時間)/(ジャストエッティング時間)を小さくし、1.0に近づけることができる。

したがつて、この発明によれば、従来品のように過剰なオーバーエッティングをすることなく、クロム残り密度を減少させることができる。

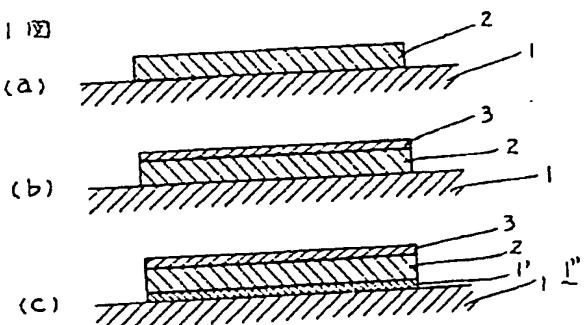
なお、以上の実施例の変形例としては、積層方5法としてスパッタリング法以外に真空蒸着法、イオンプレーティング法等でもよく、透明基板としてソーグライムガラス以外にボロンシリケートガラス、石英ガラス、サファイア等はもとより、透明導電膜付きの透明基板でもよく、また、第5図10aに示した表面反射率の高いフォトマスクプランクについても低反射タイプと同様な効果が得られる。また、本発明はクロム層22とクロム層23を分離して説明したが、透明基板10の界面付近から遠ざかるに従つて連続的に窒化度を減少させ15てもよい。

図面の簡単な説明

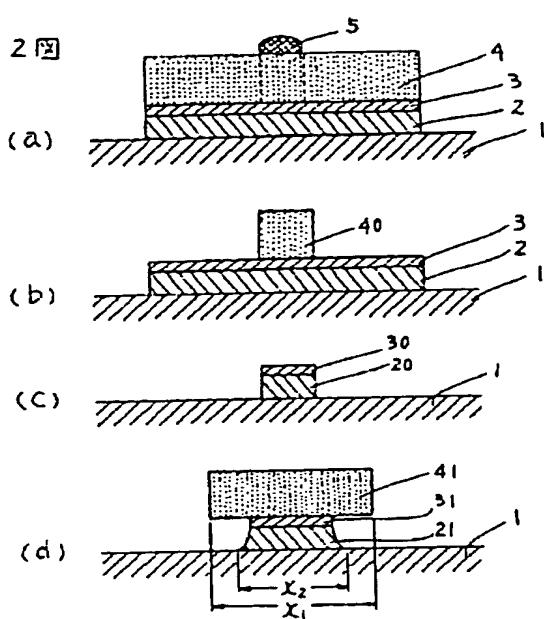
第1図a、b及びcは従来のフォトマスクプランクの断面図、第2図a、b、cは前記プランクを使用したレジスト塗布、露光現象、レジスト剥離の各工程の断面図、第2図dはアンダーカット量を示す断面図、第3図はエッティング時間に対するアンダーカット量及びクロム残り密度を示す特性図、第4図は(エッティング時間)/(ジャストエッティング時間)に対するクロム残り密度を示す特性図、第5図は本発明によるフォトマスクプランクの断面図、並びに第6図は窒化度に対するエッティング速度の特性図である。

10 ……透明基板、22 ……窒化度が大きいクロム層、23 ……窒化度が小さいクロム層、32 30 ……酸化クロム層。

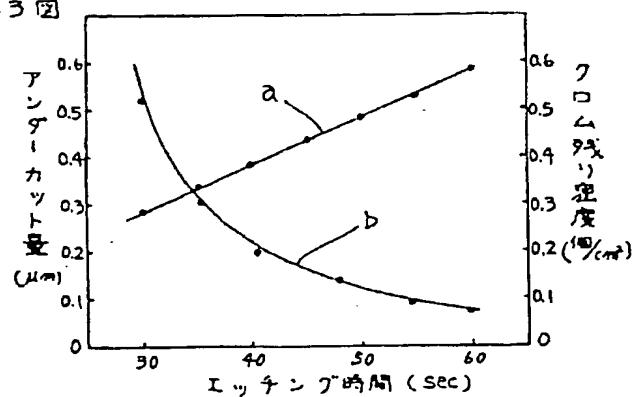
第1図



第2図



第3図



第4図

